ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

УДК 548.73

Е. А. ЛЕВИКОВ, Л. В. ЛЕВИКОВА

НОВЫЙ МЕТОД ЛОКАЛЬНОГО РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА— МЕТОД СХОДЯЩЕГОСЯ В ТЕЛЕСНОМ УГЛЕ ПУЧКА РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ

(Представлено академиком Γ . В. Курдюмовым 14 X 1971)

Разработан новый метод локального рентгеноструктурного анализа — метод сходящегося в телесном угле пучка рентгеновских лучей. Этот метод аналогичен методу Косселя (1-3) и сочетает возможности как метода «истинных» линий Косселя (высокую локальность), так и метода расходящегося пучка (6-8) (возможность проведения исследований «на отражение» от кристаллов с любой плотностью дислокаций).

Сущность метода. В облучаемой точке О кристалла (рис. 1) собирается пучок рентгеновских лучей, распространяющихся от зеркала антикатода. Зеркало антикатода является основанием конуса сходимости, имеющего вершину в точке О. Среди всех направлений первичных лучей найдутся такие, которые (для характеристического излучения антикатода) составляют брэгговские углы с какими-либо кристаллографическими плоскостями кристалла. Совокупность таких направлений образует круговой конус с осью, совпадающей с нормалью к отражающей плоскости. Угол образующей конуса с нормалью составляет ½ п — 0. Зеркально отра-

женные рассматриваемой плоскостью лучи распространяются вдоль образующих этого же конуса и могут быть зарегистрированы, например, на плоскую пленку в виде псевдокосселевских линий, представляющих части эллипсов (рис. 3).

Размеры облучаемой области зависят от диаметра выходного отверстия диафрагмы d и могут быть доведены до 10-20' (дальнейшее уменьшение диа-

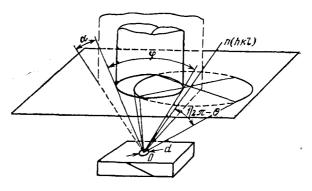


Рис. 1. Схема получения рентгенограмм в сходящемся пучке

фрагмы нежелательно из-за резкого увеличения времени экспозиции). Таким образом, этот метод позволяет получать рентгенограммы от малых областей монокристалла или отдельных зерен поликристалла.

По рентгенограммам, полученным методом сходящегося пучка, может быть проведено индицирование, прецизионное ориентирование и определение параметров решетки, исследование субструктуры кристаллов и т. д.

Орментирование монокристаллов. Метод сходящегося пучка позволяет проводить индицирование несколькими способами. Остановимся на одном из них.

Обычно на рентгенограмме косселевского типа присутствуют линии, полученные от одной и той же плоскости в излучении K_{α} и K_{β} . Измеряют

угол типа $\alpha_1 O \beta$ (рис. 2) и сравнивают его с расчетными данными для исследуемого кристалла. Выход нормали On находят, откладывая $\angle \alpha_1 On = \frac{1}{2}\pi - \theta_{\alpha_1(hhl)}$. Определения выходов нормалей к трем плоскостям достаточно для ориентирования кристалла. Точность ориентирования по одному снимку, полученная по этому методу, 10-20'.

Определить по рентгенограмме, полученной в сходящемся пучке, с такой же точностью, как и обычно для линий Косселя (2). Однако метод сходящегося пучка имеет преимущества для проведения локальных исследований. Здесь, в частности, интересной является возможность определения макронапряжений в изделиях, изготовленных из крупнозернистых

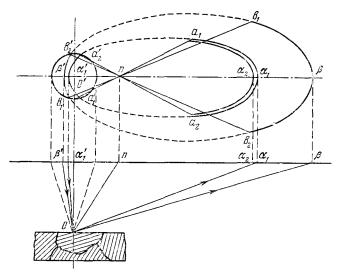


Рис. 2. Схема индицирования по методу сходящегося пучка

материалов. Такие изделия не могут быть исследованы дифрактометрически. Если один снимок содержит отражения от 6 и большего числа плоскостей, то при деформировании в упругой области (при заданном тензоре напряжений) может быть полностью определен тензор деформаций и, следовательно, тензор модулей упругости кристалла. Методы определения параметра решетки аналогичны методам определения параметров по линиям Косселя (2).

Анализ уширения дифракционных линий. Существующие методы анализа ширины и формы дифракционных линий относятся к брэгговским отражениям, на ширину которых оказывает влияние лишь микронапряжение решетки (разброс параметров) и дифракционные эффекты, связанные с малостью областей когерентного рассеяния. Для монокристаллов наряду с брэгговскими отражениями возможна регистрация линий другого типа, которые обычно называют «кривыми качания». Ширина кривых качания определяется не только микроискажениями решетки и размерами областей когерентного рассеяния, но и разориентациями этих областей. Однако при получении кривых качания информацию получают от больших объемов кристалла (больше 10⁴ µ³).

Преимущество метода сходящегося пучка — локальность исследования. Можно исследовать объемы меньше $10^3 \, \mu^3$.

Кривые косселевского типа, в том числе и полученные в сходящемся пучке, имеют такую же природу, как «кривые качания», т. е. уширение линий определяется микроискажениями, размерами областей когерентного рассеяния и разориентациями этих областей.

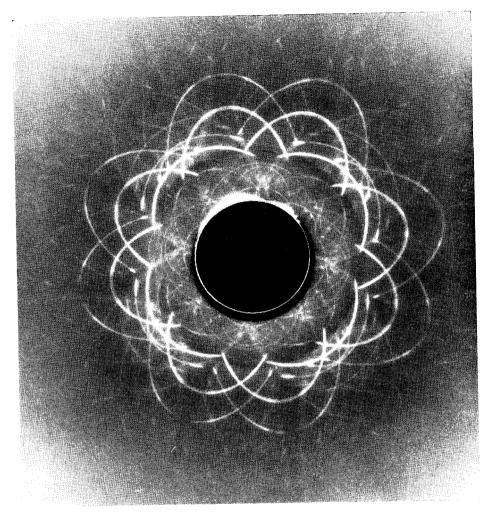


Рис. 3. Рентгенограмма молокристалла нпобля, полученная по методу сходящегося пучка (медный антикатод)

Поскольку последовательная теория уширения линий Косселя отсутствует, мы воспользуемся частным случаем, при котором анализ формы таких линий все же может быть проведен, а именно: при хаотическом распределении дислокаций в кристалле есть теория уширения брэгговских линий (*) и теория дополнительного уширения «кривых качания», вызванного резориентациями (5).

Дополнительно уширение $B_{ ext{op}}pprox 2\,|\,b\,|\,\sqrt{
ho}$, где ho — плотность дислокаций, b — вектор Бюргерса. Распределение интенсивностей линий косселевского тина можно описать таким соотношением:

$$I(\theta) = \int f_{\delta p}(x) f_{\delta p}(x - y) \varphi(y - \theta) dx dy; \tag{1}$$

 $j_{\rm 5p}$ — для брэгговских линий, $f_{\rm op}$ — функция, описывающая разориентацию, ф — распределение интенсивностей, вызванное инструментальными причи-

нами. Если форма всех кривых гауссова, что можно принять с небольшой погрешностью для всех функций, т. е.

$$f \sim \exp\left(-\pi\theta^2/B^2\right),\tag{2}$$

 θ — отклонение от брэгговского угла θ_{B} , В — «полуширина» соответствующей привой, то для брэгговских линий

$$B^2 = B_{0p}^2 + B_0^2, (3)$$

для линий в сходящемся пучке

а по Вор из (5)

$$B_{\rm ex}^2 = B_{\rm 5p}^2 + B_{\rm 0p}^2 + B_{\rm 0}^2, \tag{4}$$

Таблина 1

Плотность дислокаций в монокристалиах молибдена, деформированных прокаткой

Степень обжатия, Е, %	Метод определения	
	рентгенографический анализ	лектронная кипомродиим
	ρ·10 ⁻¹⁰ , cm ⁻²	
28 54 64	$\begin{bmatrix} 1,8\pm0,3\\ 2,3\pm0,5\\ 4,6\pm1 \end{bmatrix}$	$3,37 \\ 3,44 \\ 3,63$

 $B_{
m op}$ измеряется дифрактометрически, $B_{
m a}$ измеряется для совершенного монокристалла-эталона; тогда можно найти

$$B_{\rm op}^2 = B_{\rm ex}^2 - B_{\rm op}^2 - B_{\rm o}^2,$$
 (5)

$$o = B_{\rm op}^2/(4b).$$

Описанным метолом определена плотность дислокаций в образцах монокристаллов молибдена, деформированных прокаткой. Данные рентгенографического анализа сравнивались для тех же образцов с результатами определения плотности дислокаций методами электронной микроскопии (табл. 1). Так как и тот и другой методы обладают определенными погрешностями, то такое совпадение результатов следует считать весьма удовлетворительным.

Приведенные результаты позволяют сделать вывод о полезности и перспективности применения метода сходящегося в телесном угле пучка рентгеновских лучей к решению целого ряда задач рентгеноструктурного

В заключение авторы выражают благодарность Л. И. Федоровой за проведение электронномикроскопических исследований, Ю. А. Бороденко и В. Ф. Долженко за помощь в проведении эксперимента.

Физико-технический институт Академии наук УССР Харьков

Поступило 11 X 1971

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

¹ W. Kossel, Ergeb. Exakten. Naturwiss., 16, 295 (1937). ² K. Lonsdale, Phil. Trans. Roy. Soc., London, 240, 249 (1947). ³ H. J. Ullrich, Physica Stat. Solidi, 20, 2, 417 (1967). ⁴ M. А. Кривоглаз, Теория рассеяния рентгеновских лучей и тепловых нейтронов реальными кристаллами, «Наука», 1967. ⁵ L. Кашfman, S. А. Кшlin, Trans. AIME, 215, 273 (1959). ⁶ И. А. Гиндин, Е. А. Левиков и др., Физ. мет. и металловед., 30, 2, 426 (1970). ⁷ T. Ellis, L. F. Nanni, J. Appl. Phys., 35, 11, 3364 (1964). ⁸ J. J. Slade, S. Weissmann, J. Appl. Phys., 35, 11, 3371 (1964).